PATENT COOPERATION TREATY.

	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	10.
NOTIFICATION OF ELECTION	Assistant Commissioner for Patents
(PCT Rule 61.2)	United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Date of mailing: 11 May 2000 (11.05.00)	in its capacity as elected Office
nternational application No.: PCT:JP99/06038	Appropriate on several of the reference: TMW 99-31 PCT
International filing date: 29 October 1999 (29.10.99)	Priority date: 30 October 1998 (30.10.98)
Applicant: ITO, Hiroyuki et al	
1. The designated Office is nereby notified of its election made X in the demand filed with the International preliminary 24 March 2000 In a notice effecting later election filed with the International preliminary 24 March 2000 In a notice effecting later election filed with the International preliminary 24 March 2000 In a notice effecting later election filed with the International preliminary 24 March 2000 In a notice effecting later election filed with the International preliminary 24 March 2000 In a notice effecting later election filed with the International preliminary 24 March 2000 In a notice effecting later election filed with the International preliminary A provided the International preliminary 24 March 2000 In a notice effecting later election filed with the International preliminary A provided the International preliminary	Examining Authority on: (24.03.00) ational Bureau on:

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer:

J. Zahra

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

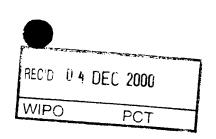
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

電話番号 03-3581-1101 内線 3225

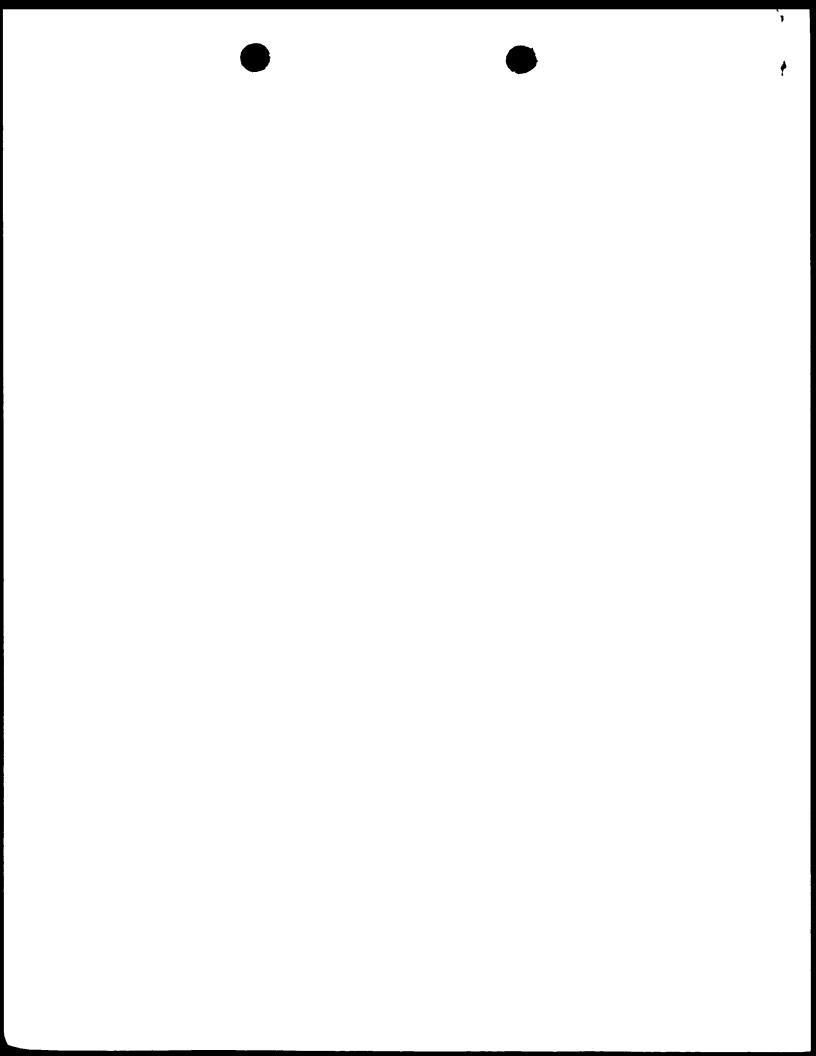
 $P \in T$

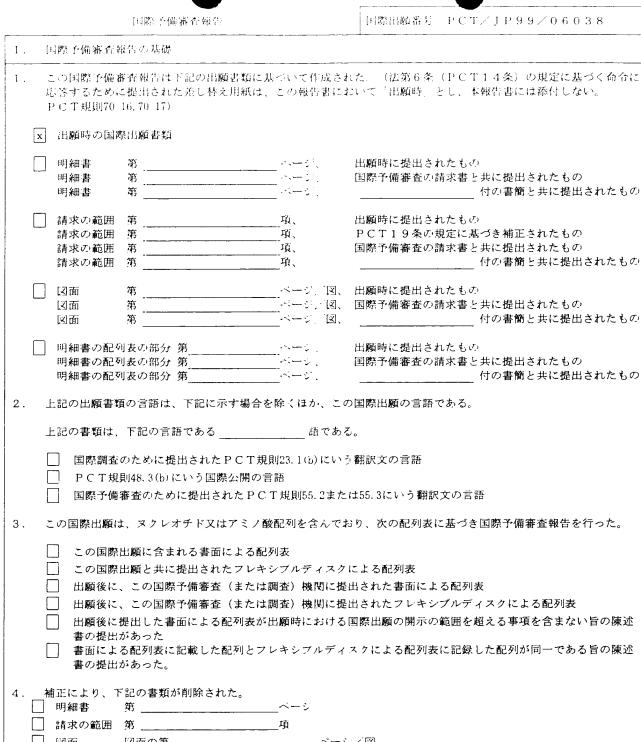
国際予備審查報告

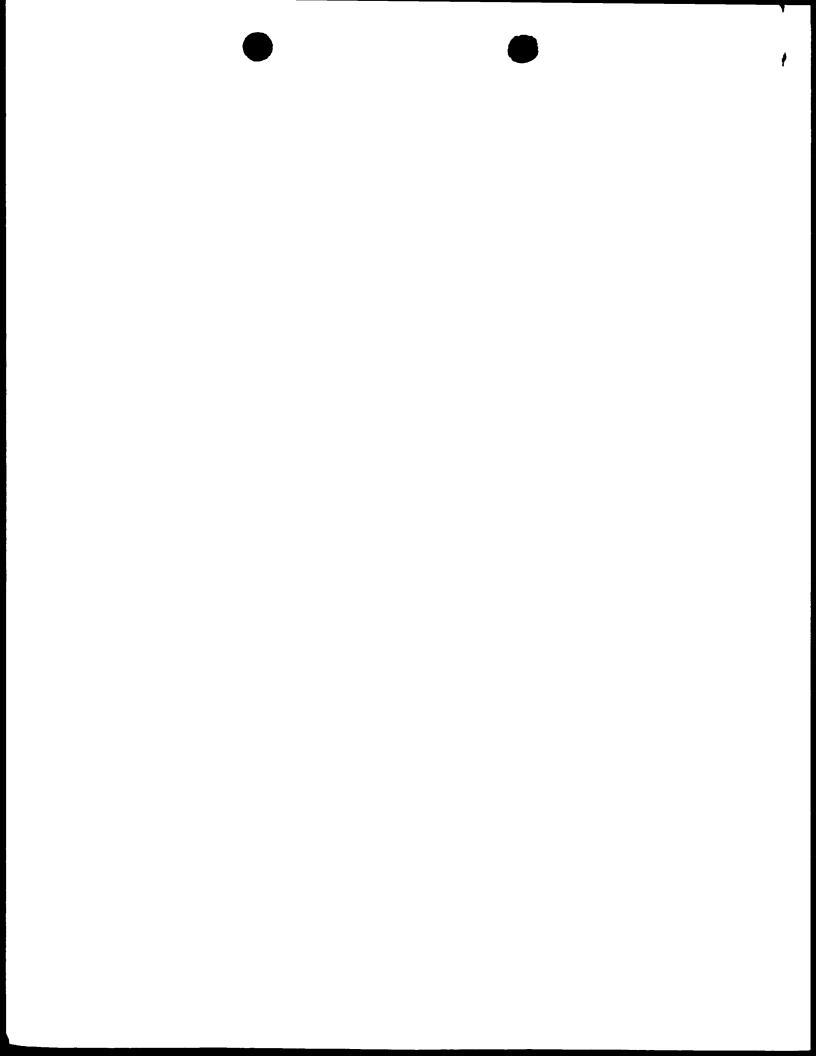
(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

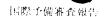


出願人又は代理人 の書類記号 TMW99-31PCT	今後の手続きについては、国際予備 IPEA	審査報告の送付通知(様式P /416)を参照すること。	CT/
国際出願番号 PCT/JP99/06038	国際出願日 (日.月.年) 29.10.99	優 先日 (日.月.年) 30.	10.98
国際特許分類(IPC) Int.Cl ⁷	H01J37/317, 37/30	0 2	
出願人 (氏名又は名称) アプライト マテリ	アルズ インコーポレイテッド		
2. この国際予備審査報告は、この表制 □ この国際予備審査報告には、所 査機関に対してした訂正を含む (PCT規則70.16及びPCT この附属書類は、全部で 3. この国際予備審査報告は、次の内容 1 図 国際予備審査報告の基礎 Ⅱ □ 優先権 Ⅲ □ 新規性、進歩性又は産業 Ⅳ □ 発明の単一性の欠如	ページである。 字を含む。	ページからなる。 発告の基礎とされた及び/又は iも添付されている。 審査報告の不作成	この国際予備審
国際予備審査の請求書を受理した日 24.03.00	国際予備審査幸	股告を作成した日 20.11.00	
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4名	堀部 値	(権限のある職員) §平 印	2 G 9 2 1 5









国際出願番号 PCT/JP99/06038

V.	新規性、進歩性又は産業上の利用可 文献及び説明	能性についての法第12条 	(РСТЗ5条(2))	に定める見解、	それを裏付ける
1.	見解				
	新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	5, 6 1-4		
	進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲 _	1 – 6		
	産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 請求の範囲	1 – 6		

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1: JP, 6-13019, A (東京エレクトロン株式会社)

21. 1月. 1994 (21. 01. 94), 全文, 第1-4図

文献2: JP, 6-51100, A (株式会社日立製作所) 25.2月.1994(25.02.94), 全文, 第1-3図

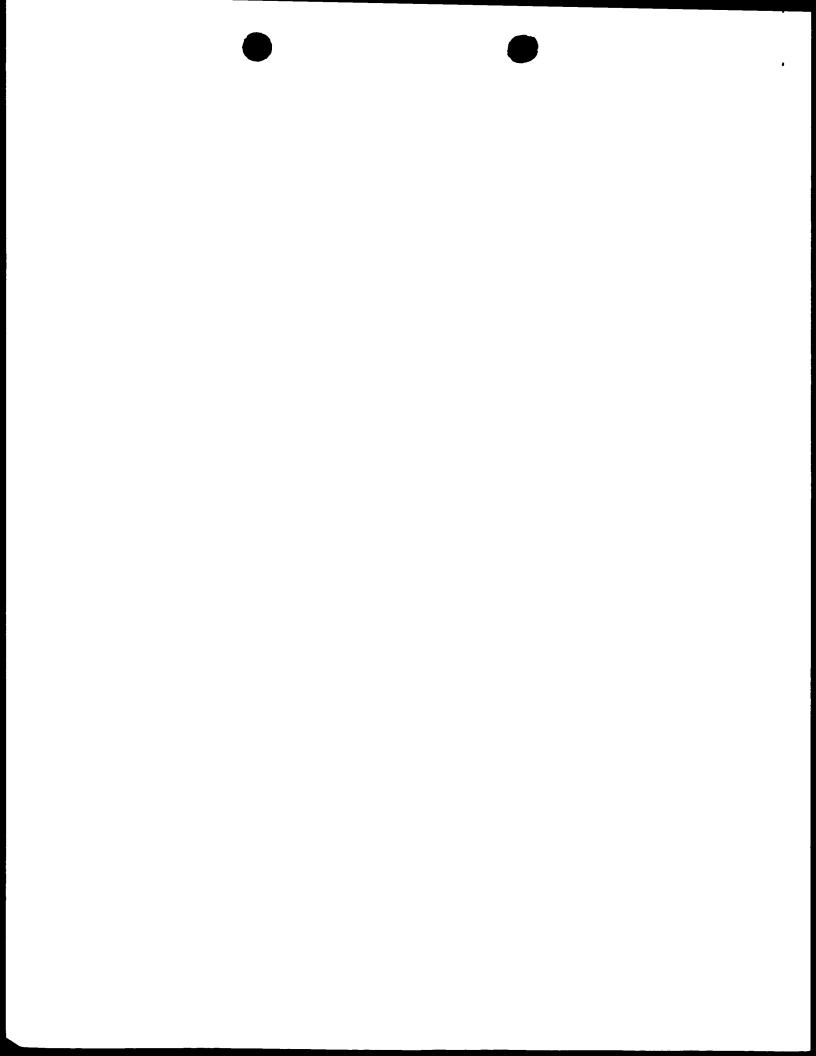
請求の範囲1-4

請求の範囲1-4は文献1により新規性を有しない。 文献1には、荷電粒子導入部の開口とイオン送出口との間に見通し規制部材により シールド部が形成され、右シールド部は、開口の上方に伸び出しており、開口によって規定される面の各点からイオンビームの送出口によって規定される面の各点に至る 直線と交わる遮蔽面を有するイオン注入装置が開示されている。

請求の範囲5,6

6は文献1,2により進歩性を有しない。 請求の範囲5,

文献2に記載されたイオン注入装置における、シールド部を形成するカバーは、ガ イド管の内壁面と鋭角をなし、且つ平板形状をなしていると認められる。文献1記載のイオン注入装置のシールド部に文献2に記載のカバーを適用すること、及び、平板形状のシールド部を平板とフレーム部材とで形成することは、当業者にとって自明で ある。



Translation

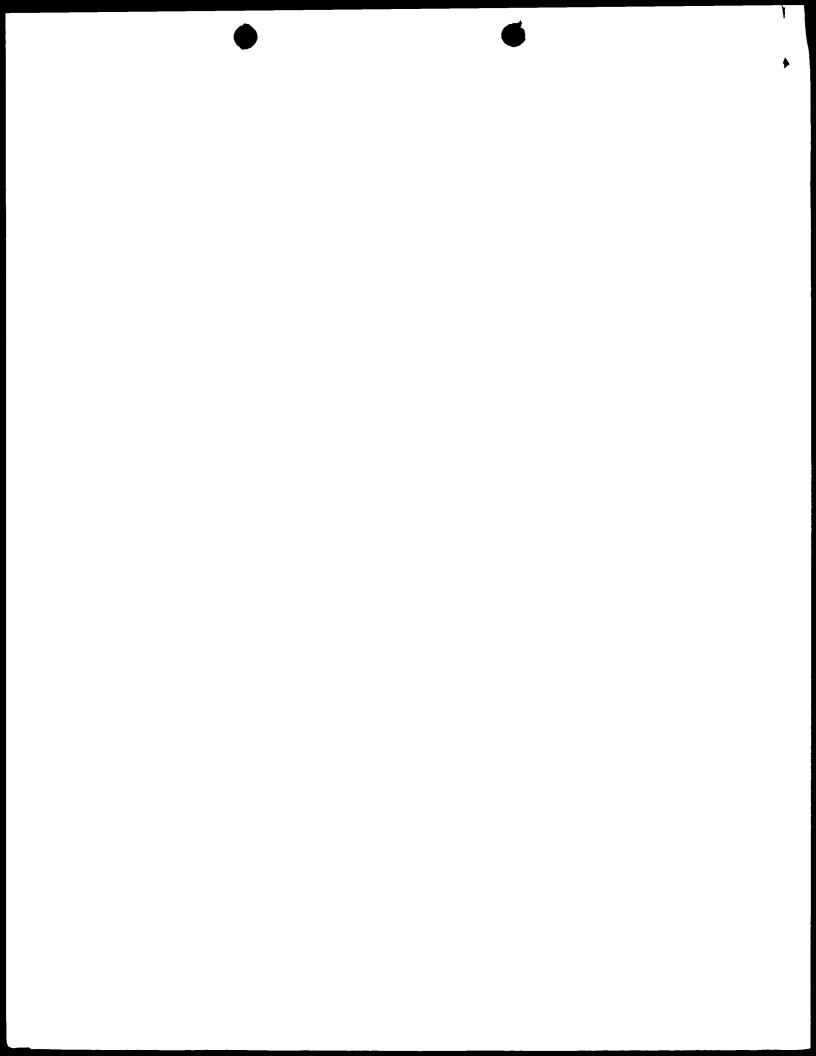
PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference TMW 99-31 PCT		NotificationofTransmittalofInternational Preliminary mination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/JP99/06038 International filing date (day month year) Priority date (day month year) 29 October 1999 (29.10.99) 30 October 1998 (30.10.9)		
International Patent Classification (IPC) or n H01J 37/302, 37/317	ational classification and IPC	
Applicant	APPLIED MATERIALS, I	NC.
and is transmitted to the applicant ac	ination report has been prepared by the coording to Article 36. 3 sheets, including this	is International Preliminary Examining Authority
This report is also accompaning the page amended and are the ba	nied by ANNEXES, i.e., sheets of the	ne description, claims and/or drawings which have ning rectifications made before this Authority (see
These annexes consist of a to	otal of sheets.	
IV Lack of unity of inv V Reasoned statement citations and explan VI Certain documents VII Certain defects in the	of opinion with regard to novelty, invovention t under Article 35(2) with regard to notations supporting such statement	entive step and industrial applicability ovelty, inventive step or industrial applicability;
Date of submission of the demand	Date of com	pletion of this report
24 March 2000 (24.0	3.00)	20 November 2000 (20.11.2000)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized	officer
Facsimile No.	Telephone \	No.

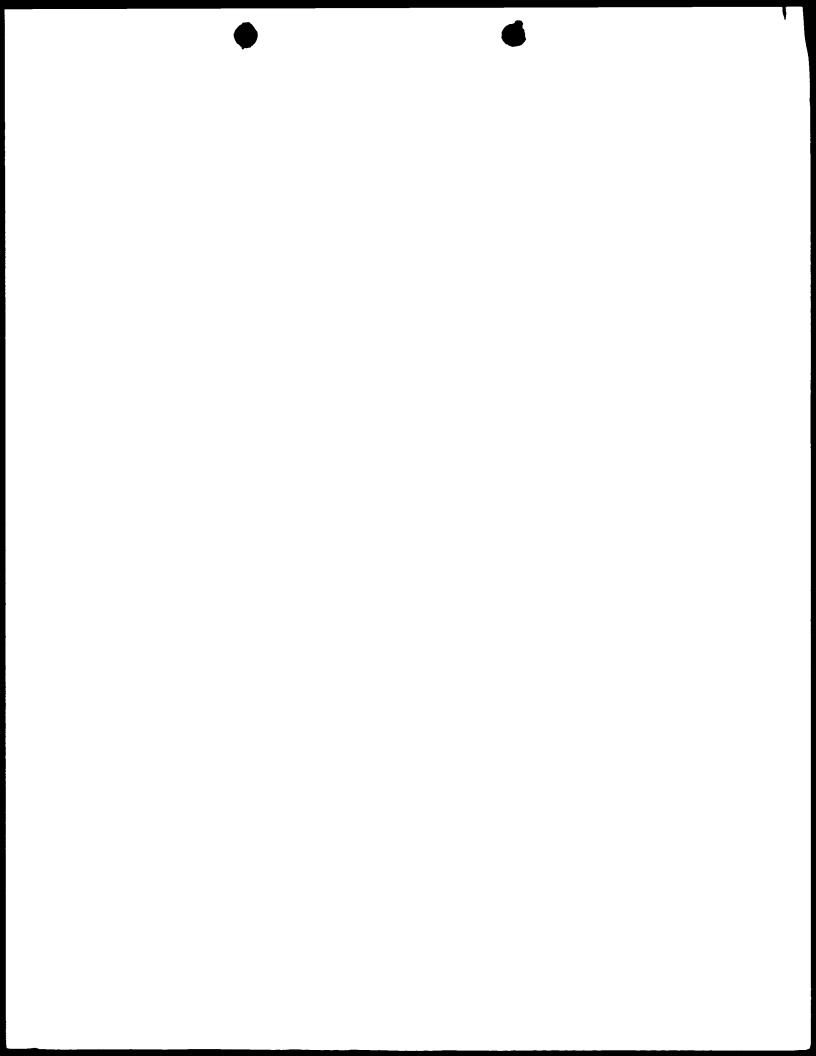


International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP99/06038

I.	Basi	s of the r	eport
1.	Wit	h regard to	o the elements of the international application:*
	\geq	the inte	ernational application as originally filed
		the des	cription:
		pages	, as originally filed
		pages	, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
		the clai	ims:
		pages	, as originally filed
		pages	, as amended (together with any statement under Article 19
		pages	, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
		the dra	wings:
		pages	, as originally filed
		pages	, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
		the seque	ence listing part of the description:
		pages	, as originally filed
		pages	, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
2.	the	internation se elemen the lan	o the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which nal application was filed, unless otherwise indicated under this item. Its were available or furnished to this Authority in the following language
3.	Wit	th regard liminary e contair	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international xamination was carried out on the basis of the sequence listing: ned in the international application in written form.
	<u> </u>	i	egether with the international application in computer readable form.
	_	1	ned subsequently to this Authority in written form.
	<u> </u>	1	ned subsequently to this Authority in computer readable form.
	<u> </u>		eatement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the tional application as filed has been furnished.
			atement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has arnished.
4.		The an	nendments have resulted in the cancellation of:
			the description, pages
			the claims. Nos.
			the drawings, sheets/fig
5.			port has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**
*	in ti		sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16).
**	Any	replacem	ent sheet containing such amendments must he referred to under item 1 and annexed to this report





International application No

PCT/JP99/06038

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

atement			
Novelty (N)	Claims	5,6	YE
	Claims	1-4	NO NO
Inventive step (IS)	Claims		YE
	Claims	1-6	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-6	YE
	Claims		NO.

2. Citations and explanations

Document 1: JP, 6-13019, A (Tokyo Electron Ltd.), 21 January 1994 (21.01.94), full text, Figs. 1 to 4

Document 2: JP, 6-51100, A (Hitachi, Ltd.), 25 February 1994 (25.02.94), full text, Figs. 1 to 3

Claims 1 to 4

Claims 1 to 4 do not appear to involve novelty in view of document 1.

Document 1 describes an ion implantation apparatus wherein (1) a shield part made of a view-restricting member is formed between the opening of the charged particle introducing part and the ion discharge exit and (2) the right-hand shield part extends out above the opening and has a shield surface that intersects with the straight lines that run from each point on the plane defined by the opening to each point on the plane defined by the ion beam discharge exit.

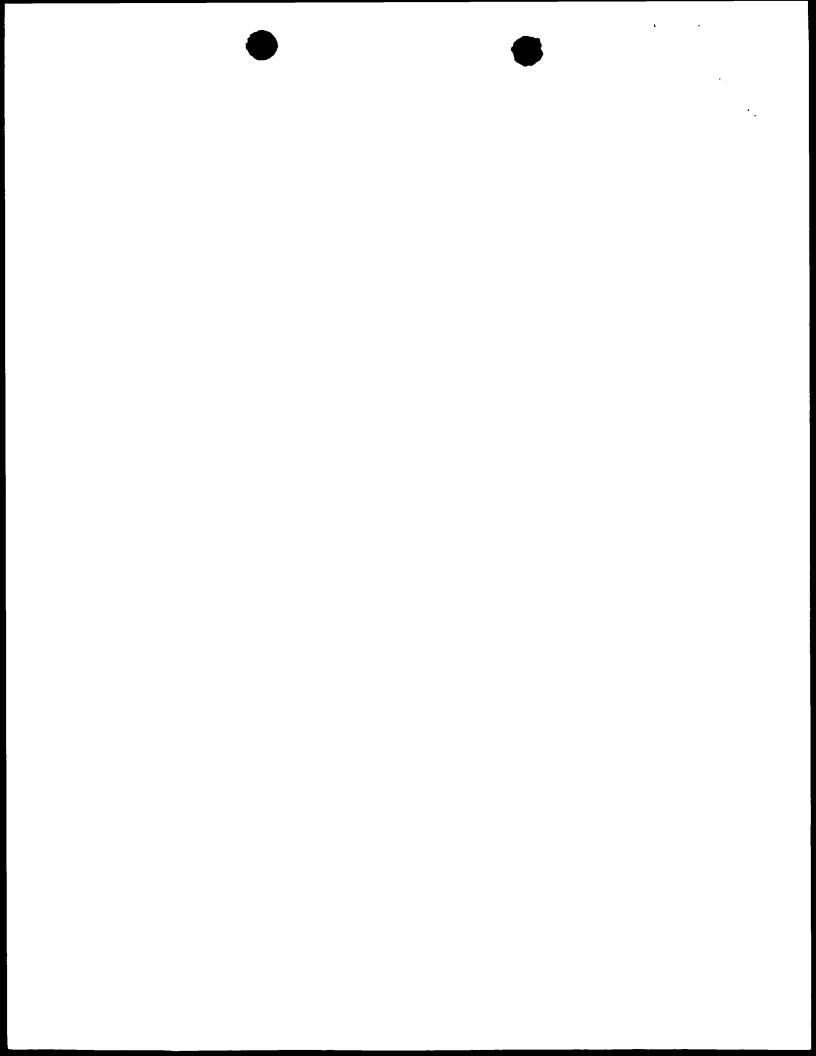
Claims 5 and 6

Claims 5 and 6 do not appear to involve novelty in view of documents 1 and 2.

The cover that forms the shield part in the ion implantation apparatus described in document 2 is found to form a sharp angle with the inner wall surface of the guide pipe and be shaped like a flat plate. The idea of using the cover described in document 2 as the shield part of the ion implantation apparatus described in document 1 and the idea of forming the flat plate-shaped shield part from a flat plate and a frame member would have been obvious to one skilled in the art.

	•	1

	IFICATION OF SUBJECT MATTER C1 ⁷ H01J37/302, 37/317			
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
		onal classification and IPC		
	S SEARCHED ocumentation searched (classification system followed by	v classification symbols)		
Int.	Cl ⁷ H01J37/302, 37/317			
Jits Koka:	on searched other than minimum documentation to the c uyo Shinan Koho 1926-1996 i Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999	Toroku Jitsuyo Shinan Ko Jitsuyo Shinan Toroku Ko	oho 1994-1999 oho 1996-1999	
	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, sear	ch terms used)	
· · · · · ·		remists of the relevant passages	Relevant to claim No.	
Category*	Citation of document, with indication, where app JP, 6-13019, A (TOKYO ELECTRON		1-3	
Λ	21 January, 1994 (21.01.94), Full text; Figs. 1 to 4 (Family: none)	HIMITED,,	1 3	
Y	JP, 6-13019, A (TOKYO ELECTRON : 21 January, 1994 (21.01.94), Full text; Figs. 1 to 4 (Family: none)	LIMITED),	4-6	
Y	JP, 6-51100, A (Hitachi, Ltd.), 25 February, 1994 (25.02.94), Full text; Figs. 1 to 3 & US, 5466929, A & US, 55765 & US, 5668368, A	338, A	4 - 6	
Y	JP, 6-267439, A (Hitachi, Ltd.) 22 September, 1994 (22.09.94), Fig. 1; Par. Nos. [0013]-[0020] (Family: none)	,	1-6	
Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
 Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "C" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family 				
25	actual completion of the international search January, 2000 (25.01.00)	Date of mailing of the international sea 01 February, 2000 (01.02.00)	
	mailing address of the ISA/ anese Patent Office	Authorized officer		
Facsimile N	No.	Telephone No.		



PCT

NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To

HASEGAWA, Yoshiki Soei Patent And Law Firm Okura-Honkan 6-12, Ginza 2-chome Chuo-ku Tokyo 104-0061 JAPON

IMPORTANT NOTIFICATION
International filing date (day/month/year) 29 October 1999 (29.10.99)
Priority date (day/month/year) 30 October 1998 (30.10.98)

- 1. The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- 2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- 3. An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- 4. The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Priority datePriority application No.Country or regional Office or PCT receiving OfficeDate of receipt of priority document30 Octo 1998 (30.10.98)10/310658JP20 Dece 1999 (20.12.99)

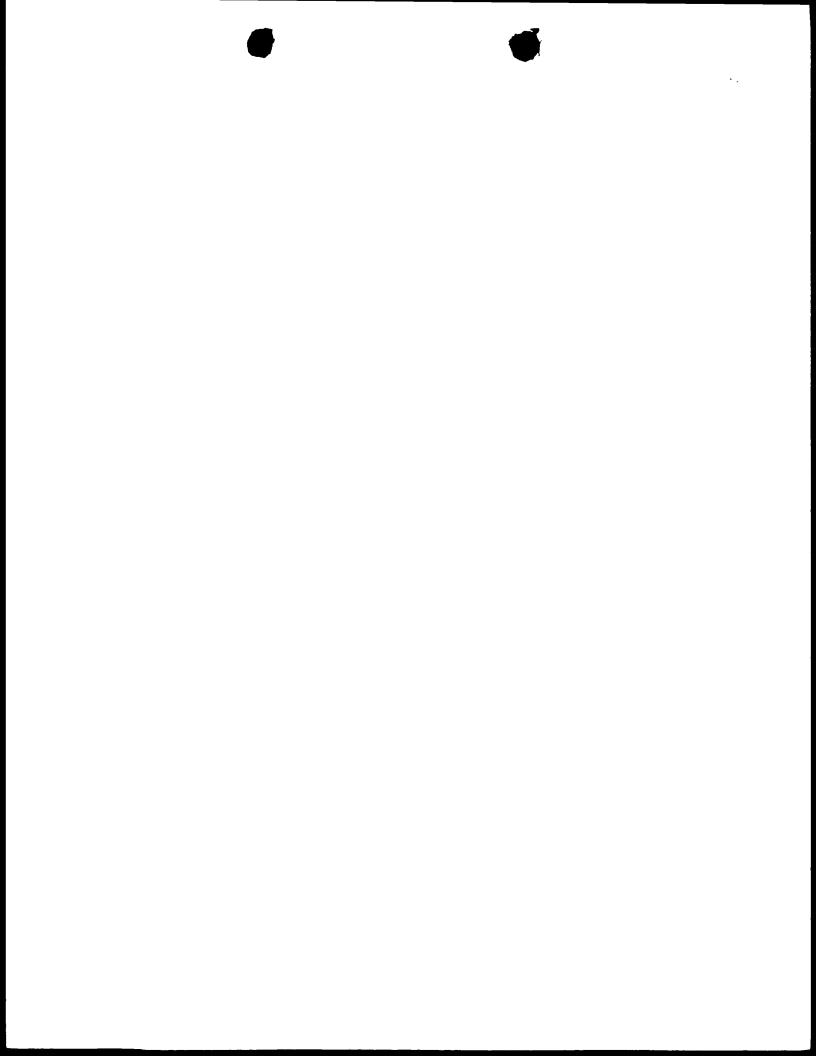
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Tessadel PAMPLIEGA

tag

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38





T-..

PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

HASEGAWA, Yoshiki Soei Patent and Law Firm Okura-Honkan 6-12, Ginza 2-chome Chuo-ku Tokyo 104-0061

Date of mailing (day/month/year) 11 May 2000 (11.05.00)

Applicant's or agent's file reference

TMW 99-31 PCT

IMPORTANT NOTICE

International application No. PCT/JP99/06038

International filing date (day/month/year)

29 October 1999 (29.10.99)

JAPON

Priority date (day/month/year) 30 October 1998 (30.10.98)

Applicant

APPLIED MATERIALS, INC. et al

 Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:

KR,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

ΕP

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 11 May 2000 (11.05.00) under No. WO 00/26938

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the **national phase**, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

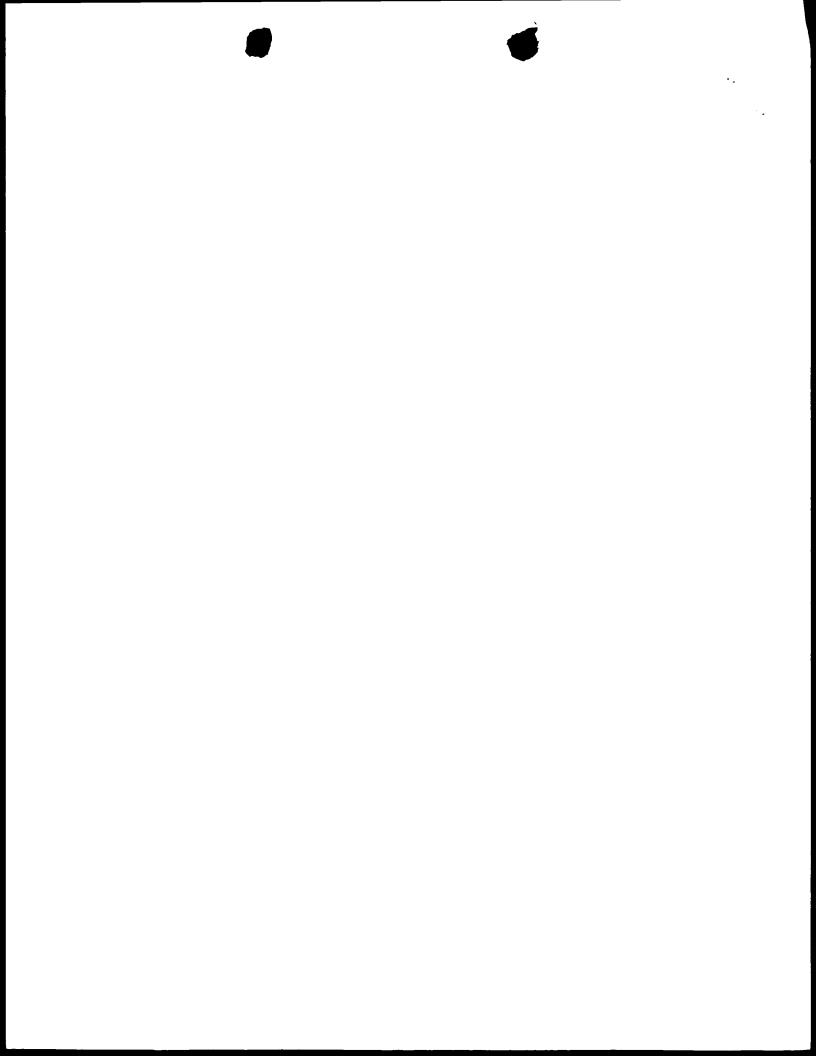
For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

J. Zahra

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35



PCT

世界知的所有権機関

際事務局



特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類7 H01J 37/302, 37/317

A1

(11) 国際公開番号

WO00/26938

(43) 国際公開日

2000年5月11日(11.05.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/06038

(22) 国際出願日

1999年10月29日(29 10.99)

(30) 優先権テータ

特願平10/310658

1998年10月30日(30.10.98)

JР

(71) 出願人 (米国を除しすべての指定国について) アプライド マテリアルズ インコーポレイテット

(APPLIED MATERIALS INC.)[US/US] 95054 カルフォルニア サンタ クララ

バウアーズアベニュー 3050 California, (US)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

伊藤裕之(ITO, Hiroyukı)[JP/JP]

阿世知大(ASECHI, Hiroshi)[JP/JP]

〒286-8516 千葉県成田市新泉14-3

アプライド マテリアルマ ジャパン株式会社内 Chiba, (JP)

弁理士 長谷川芳樹、外(HASEGAWA, Yoshiki et al.)

〒104-0061 東京都中央区銀座二丁目6番12号

大倉本館 創英国際特許法律事務所 Tokyo, (JP)

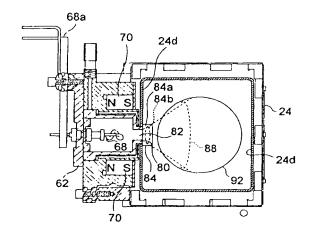
(81) 指定国 KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

添付公開書類

国際調査報告書

(54) Title: APPARATUS FOR ION IMPLANTATION

(54)発明の名称 イオン注入装置



(57) Abstract

An apparatus for ion implantation comprises an ion source (18) for producing ions; an ion implantation head (14) for implanting a substrate (92) with ions generated by the ion source (18); a charge generator (62) for producing particles charged oppositely to the ions; a beam guide (24) including an entrance (24a) through which ions are received from the ion source (18), an exit (24b) through which ions are sent to the ion implantation head (14), a guide tube (24c) extending from the entrance (24a) to the exit (24b) and a section (80) having an opening (82) in the inside (24d) of the guide tube (24c) for introducing charged particles from the charge generator (62) into the guide tube (24c); and a shield (84) disposed between the opening (82) in the section (80) and the exit (24b) in the guide tube (24c). The shield (84) includes a shield surface (84a) for stopping polluted particles from reaching the wafer.





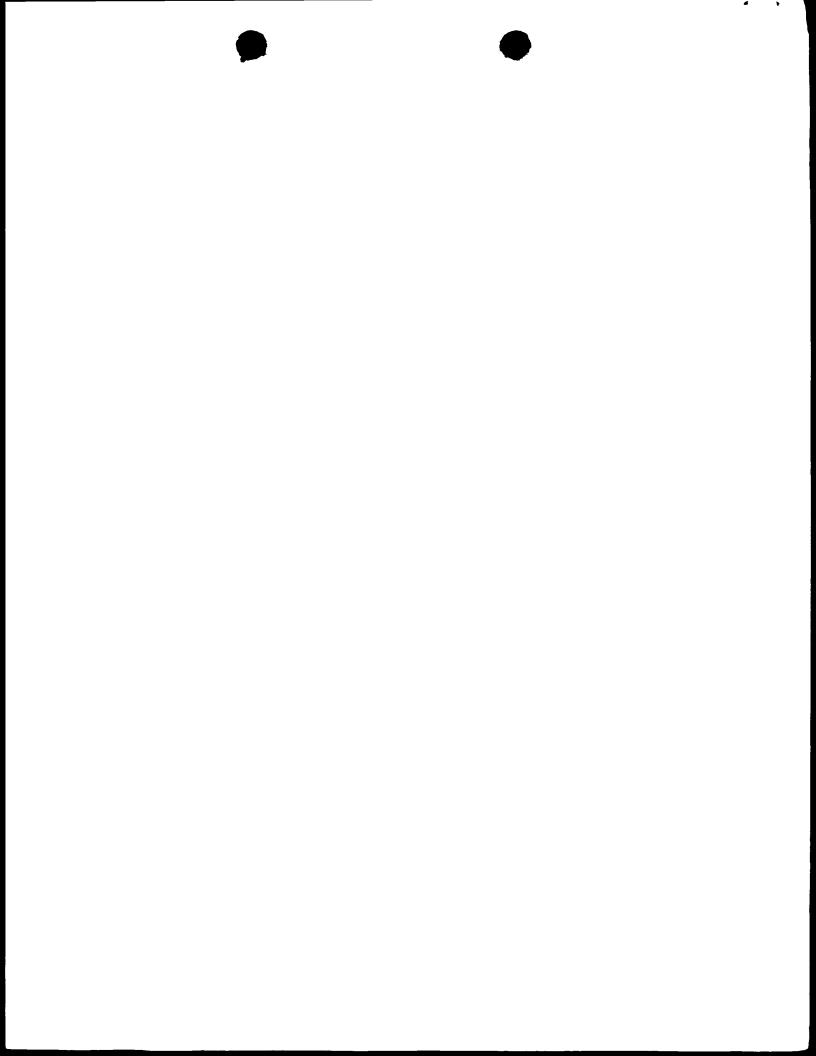




国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 TMW99-31PCT	今後の手続きについては、	国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/2 及び下記5を参照すること。	220)
国際出願番号 PCT/JP99/06038	国際出願日 (日.月.年) 29.10.99	優先日 (日.月.年) 30.10.99	
出願人 (氏名又は名称) アプライド マテリアルズ イ	ンコーポレイテッド		
国際調査機関が作成したこの国際調査この写しは国際事務局にも送付される		(PCT18条) の規定に従い出願人に送付する。	
この国際調査報告は、全部で3_	ページである。		
この調査報告に引用された先行も	支術文献の写しも添付されて	ている。	
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除く 区 この国際調査機関に提出さ		いたものに基づき国際調査を行った。 づき国際調査を行った。	
b. この国際出願は、ヌクレオチト この国際出願に含まれる書		ごおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。	
	れたフレキシブルディスクし		
出願後に、この国際調査機 出願後に、この国際調査機			
		国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨 <i>の</i>	陳述
	た配列とフレキシブルディン	スクによる配列表に記録した配列が同一である旨 <i>の</i>	陳述
2. 請求の範囲の一部の調査カ	ぶできない(第I欄参照)。		
 3. 発明の単一性が欠如してい	いる(第11福参照)。		
4. 発明の名称は 🔲 出願	種人が提出したものを承認す	⁻ వ.	
□ 次に	ニ示すように国際調査機関が	作成した。	
5. 要約は 🗓 出願	頂人が提出したものを承認す	ావ.	
国際		法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定に 個人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以降 「ることができる。	
6. 要約書とともに公表される図は、 第 <u>5</u> 図とする。 X 出願	頂人が示したとおりである。	□なし	
□ 出願	種人は図を示さなかった。		
	図は発明の特徴を一層よく表	もしている。	





A 桑明(/) 應了人分野(/)分類 (国际行行为银(工厂)。	C) i	IP	(国際特許分類(発明の属する分野の分類	Α.
---------------------------------	------	----	----------	-------------	----

Int Cl 7 H01J37/302, 37/317

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int C17 H01137/302, 37/317

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-1999年

日本国登録実用新案公報

1994-1999年

日本国実用新案登録公報

1996-1999年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

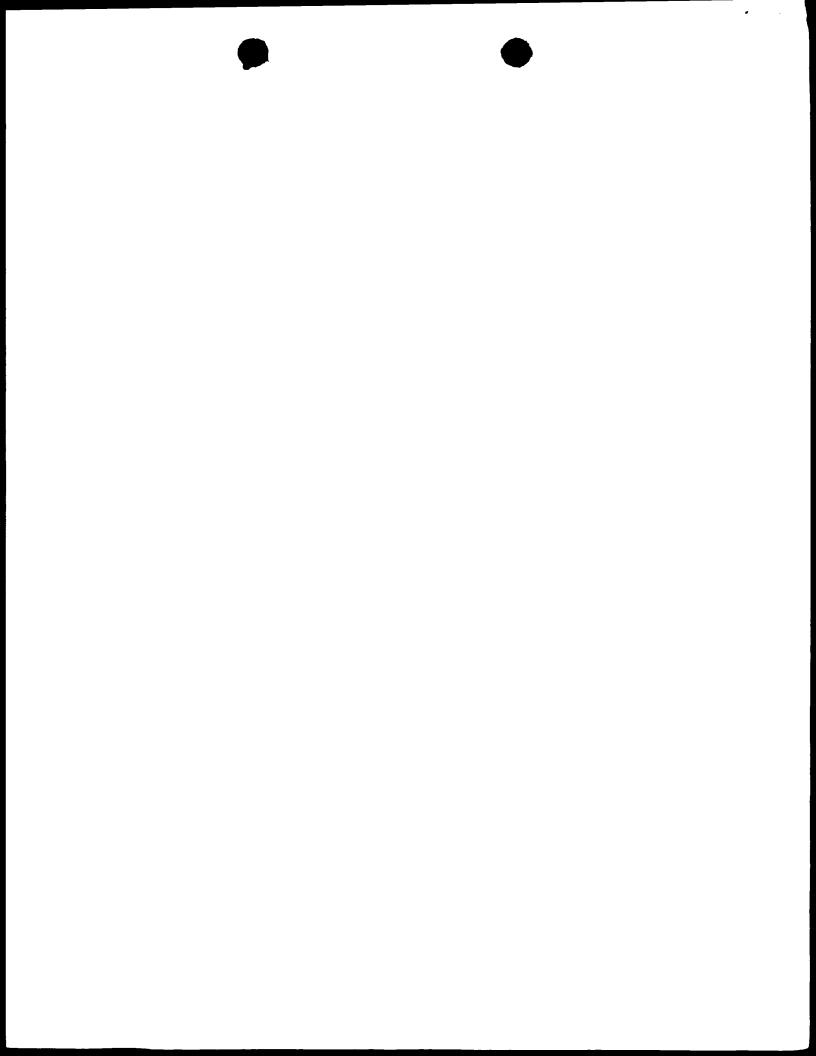
 C. 関連する	関連すると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号			
X	JP、6-13019、A(東京エレクトロン株式会社) 21.1月.1994(21.01.94)全文、第1-4図(ファミリーなし)	1-3			
Y	JP、6-13019、A(東京エレクトロン株式会社) 21.1月.1994(21.01.94)全文、第1-4図(ファミリーなし)	4-6			
Y	JP、6-51100、A(株式会社日立製作所) 25.2月.1994(25.02.94)全文、第1-3図 & US、5466929、A & US、5576538、A & US、5668368、A	4-6			

区欄の続きにも文献が列挙されている。

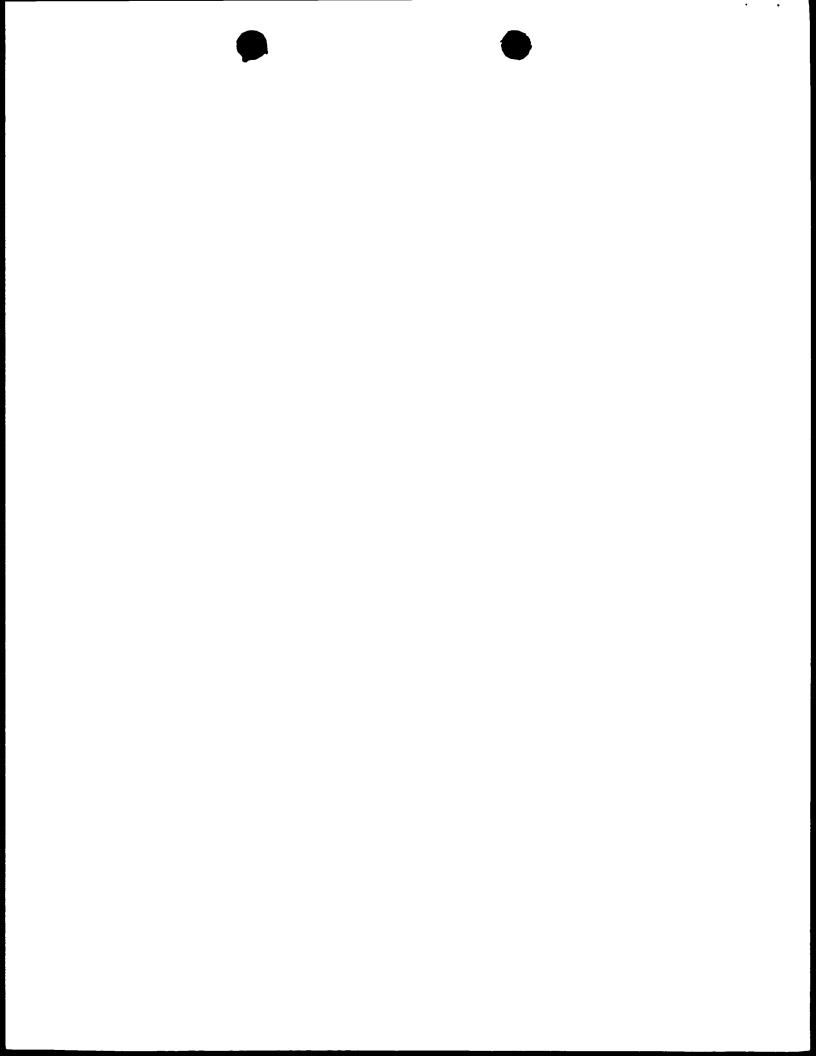
| パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献



	FINAL PROPERTY OF THE PROPERTY	1017 710				
C (続き).						
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときに	関連する 請求の範囲の番号				
Y	JP、6-267439、A(株式会社日立製作 22.9月.1994(22.09.94) 第1図、段落 (ファミリーなし)	所)	1-6			



世界知的所有権機関 国 際 事 務 局 条約に基づいて公開された国家出願



(51) 国際特許分類7 H01J 37/302, 37/317

(11) 国際公開番号 $\mathbf{A}\mathbf{1}$

WO00/26938

(43) 国際公開日

2000年5月11日(11.05,00)

(21) 国際出願番号

PCT JP99 06038

(22) 国際出願日

1999年10月29日(29.1099)

(30) 優先権テータ

特願平10/310658

1998年10月30日(30.10 98) JP

(71) 出願人 (米国を除らすべての指定国について) アプライト マテリアルズ インコーポレイテット

(APPLIED MATERIALS INC.)[US/US]

95054 カルフォルニア サンタ クララ

パウマークアバニュー 3050 California, (US)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(計園についてのみ)

伊藤裕之(ITO, Hiroyuki)[JP/JP]

阿世知大(ASECHI, Hiroshi)[JP/JP]

〒286-8516 千葉県成田古新泉14-3

アプライト マテリアルマ シャパン株式会社内 Chiba, (JP)

(74) 代理人

弁理士 長谷川芳樹、外(HASEGAWA, Yoshiki et al.)

〒104-0061 東京都中央区銀座二丁目6番12号

大倉本館 氰英国際特許法律事務所 Tokyo, (JP)

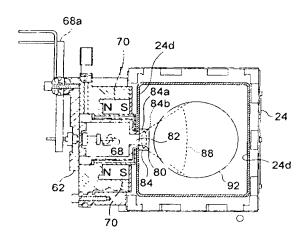
(81) 指定国 KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

添付公開書類

国際調査報告書

(54)Title: APPARATUS FOR ION IMPLANTATION

(54)発明の名称 イオン 庄入装置



(57) Abstract

An apparatus for ion implantation comprises an ion source (18) for producing ions; an ion implantation head (14) for implanting a substrate (92) with ions generated by the ion source (18), a charge generator (62) for producing particles charged oppositely to the ions; a beam guide (24) including an entrance (24a) through which ions are received from the ion source (18), an exit (24b) through which ions are sent to the ion implantation head (14), a guide tube (24c) extending from the entrance (24a) to the exit (24b) and a section (80) having an opening (82) in the inside (24d) of the guide tube (24c) for introducing charged particles from the charge generator (62) into the guide tube (24c); and a shield (84) disposed between the opening (82) in the section (80) and the exit (24b) in the guide tube (24c). The shield (84) includes a shield surface (84a) for stopping polluted particles from reaching the wafer.

イオンを生成するイオン源部(18)と、イオン源部(18)において生成されたイオンが基板(92)にイオン注入されるイオン注入部(14)と、イオンと反対の電荷を有する荷電粒子が発生される荷電粒子発生器(62)と、イオン源部(18)からのイオンを受け入れるための受入口(24a)、イオン注入部(18)へイオンを送出するための送出口(24b)、受入口(24a)から送出口(24b)に伸びるガイド管(24c)、およびガイド管(24c)の内面(24d)にその開口(82)が設けられ荷電粒子発生器(62)からの荷電粒子をガイド管(24c)内に導くための導入部(80)、を有するビームガイド部(24)と、ガイド管(24c)の内部において、導入部(80)の開口(82)と送出口(24b)との間に位置するシールド部(84)と、を備える。シールド部(84)の遮蔽面(84a)が、汚染粒子のウエハへの到達を阻止する。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

明細書

イオン注入装置

技術分野

5

10

15

20

. 25

本発明はイオン注入装置に関し、特に荷電粒子発生器から生じる汚染粒子によって基板が汚染されることを防止できるイオン注入装置に関する。

背景技術

大電流イオン汪入装置は、単位時間当たりに多数のイオンを基板に導入するために、大きな電流値を有するイオンヒームを用いてイオン汪入を行う。このため、イオン注入を行っているときに基板自体が徐々に帯電していく。この帯電電荷が放電すると、基板は放電のために損傷を受けることがある。このような事態を避けるために、チャージニュートライザを用いて基板の帯電を防止している。チャージニュートライザは、基板の帯電による損傷を緩和するために電子を発生させて、電子が有する負電荷とイオン注入されるイオンの正電荷とを中和する。

発明の開示

しかしながら、チャージニュートライザは、電子を発生するためにフィラメントに電流を流して加熱しているので、加熱されたフィラメントからは電子だけではなく、フィラメントを構成する金属粒子も飛び出す。この金属粒子は、多くの場合、基板に到達すると基板上に形成されるデバイスに好ましくない影響を与える。このため、チャージニュートライザは、基板に対する汚染源の一つとなる。

本発明の目的は、このような金属汚染を低減することが可能なイオン注入装置を提供することにある。

本発明に係るイオン注入装置は、イオンを生成するイオン源部と、イオン源部 において生成されたイオンが基板にイオン注入されるイオン注入部と、イオンと

10

15

20

25

反対の電荷を有する荷電粒子が発生される荷電粒子発生器と、イオン源部からのイナンを受け入れるための受入口、イオンは入部にイオンを送出するための送出口、受入口から送出口に伸びるガイド管、およびガイド管の内面にその開口が設けられ荷電粒子発生器からの荷電粒子をガイド管内に導くための導入部、を有するビームガイド部と、ガイド管の内部において導入部の開口と送出口との間に位置するシールド部と、を備える。

このように、イオン源部において生成されたイオンをイオン注入部に送るために通過するビームガイド部には、イオンと反対の電荷を有する荷電粒子が発生される荷電粒子発生器が設けられている。このため、この荷電粒子発生器において基板に対して汚染物質となる汚染粒子も発生される。しかしながら、導入部の関口と送出口との間に位置するシールド部をガイド管の内面に設けたので、ガイド管内壁の開口から飛び出して基板に到達する汚染粒子の飛行経路が遮断可能となる。

本発明に係るイオン注入装置では、シールド部は、導入部の開口によって規定 される面の各点からイオン注入部に配置されるイオン注入されるべき基板の表面 の各点に至る直線と交わる遮蔽面を有するようにしてもよい。

このような遮蔽面を設けると、ガイド管内壁の開口から飛び出して基板に直接に到達する汚染粒子の経路が遮蔽面によって遮断される。

本発明に係るイオン注入装置では、シールド部は、開口の縁部近傍から開口の上方に伸び出す遮蔽面を有するようにしてもよい。

このように、シールド部が開口の縁部近傍から開口の上方に伸び出す遮蔽面を 設けると、ガイド管内壁の開口から飛び出してイオン注入部に基板に直接に到達 する汚染粒子の経路が、簡単な構造のシールド部によって遮断される。

本発明に係るイオン注入装置では、シールド部は、導入部の開口によって規定される面の各点からイオンビーム部の送出口によって規定される面の各点に至る直線と交わる遮蔽面を有するようにしてもよい。

このような遮蔽面を設けると、送出口に面する位置において基板が移動している途中においても、導入部の開口から飛び出して基板に直接に到達する汚染粒子の経路が遮蔽面によって遮断される。

また、本発明に係るイオン注入装置において、シールド部は、遮蔽面がガイド 管の内壁面と鋭角をなし、且つ、平板形状をなすように構成してもよい。また、 シールド部は、遮蔽面を有すると共にガイド管の内壁面と鋭角をなして配置され た平板と、この平板を支持するフレーム部材と、を含むように構成してもよい。

図面の簡単な説明

 $\tilde{\mathbf{5}}$

- 10 図 1 は、本発明に係るイオン主入装置を示す分解斜視図である。
 - 図2は、本発明に係るイオン注入装置の概略構成図である。
 - 図3は、受入口から送出口を見たときのビームガイド部内部の斜視図である。
 - 図4は、図3の I-I'断面における縦断面図であり、イオンビームが進行する方向に向いた軸を含む平面においてビームガイド部を模式的に示している。
- 15 図 5 は、図 4 の II II'断面における断面図である。

発明を実施するための最良の形態

本発明の好適な実施形態を図面を参照しなから説明する。可能な場合には、同一の部分には同一の符号を付して重複する説明を省略する。

20 本発明の実施の形態に係るイオン注入装置10を図1および図2を用いて説明 する。図1は、本発明に係るイオン注入装置の好適な実施形態を示す分解斜視図 である。図2は、本実施形態のイオン注入装置の概略構成図である。

> 図1および図2を参照すると、イオン注入装置10は、主として、イオン源部 12と、イオン注入部14と、ビームガイド部24と、を備える。

25 イオン源部12は、イオンを生成してイオンビーム(IB)を形成する。イオン注入部14にはウエハ(基板)Wが配置されており、イオン源部12において

10

15

20

25

生成されたイオンがこのウエハWにイオンほ人される。ビームガイド部24は、イオン原部12(詳細には、反述の後段加速系23)に接続されイオンを受け入れるための受入口、イオン注入部14に対する開口となりイオンを送出するための送出口、受人口から送出口に伸びるガイド管、を有する。

イオン源部12は、イオン生成系18と、イオンヒーム引き出し、前段加速系20と、質量の析系22と、後段加速系23と、を有する。これらの各系は、ハウジングまたはチューブ(管)により囲まれている。イオンビーム引き出し、前段加速系20及び後段加速系23には、減圧手段として真空ポンプ、例えばターボ分子真空ポンプ26、28がそれぞれ接続されている。このため、イオンビーム引き出し、前段加速系20および後段加速系23の各々の内部は、所定の真空度まで減圧される。

イオン生成系 1 8 は、ガス供給源(図示せず)から供給されるドーピング不純物を含むガスを放電させることによって、ドーピングイオンを含む高密度のプラズマを形成することができる。イオンピーム引き出し・前段加速系 2 0 は、イオン生成系 1 8 との間に設けられた電位差を利用して、イオン生成系 1 8 内のプラズマからドーピングイオンを引き出すと共に、これを加速して、イオンピーム (IB)を形成する。質量分析系 2 2 には、質量分析用マグネット(図示せず)が配置されている。このため、イオン引き出し・前段加速系 2 0 において獲得した運動エネルギと、質量分析マグネットの磁場とによって決定されるイオン種のみがイオン源部 1 2 から取り出される。また、イオンビーム(IB)はイオン源部 1 2 から取り出される。また、イオンビーム(IB)はイオン源部 1 2 から取り出された後に、後段加速系 2 3 を通過しながら更に加速されて、ビームガイド部 2 4 に到達するまでにイオン注入に適切な所定の運動エネルギ(加速エネルギ)を獲得する。

ビームガイド部 (チューブ) 2.4 は、受入口にて後段加速系2.3 に接続されている。ビームガイド部2.4 は、この受入口からイオンを受け入れて、イオン注入部1.4 に向いて面して開口した送出口からイオンを送り出す。このイオンは、イ

10

15

20

25

オン注入部14においてウエハWに注入される。

一方、イオン注入部14は、ボックスタイプのターゲットチャンバ30と、クーゲットチャンバ30内に配置されたウエハ支持ホイール32とを備えている。

ターゲットチャンバ30の一方の壁面には、後段加速至23に一端が接続されたビームガイド部24の開口34かウエバWと対面可能な位置になるように、ウェバガイド部24か配置されている。また、ヒームガイド部24は、ターゲットチャンバ30内へ開口34を向けて突出している。他方の壁面には、開口34に対面する位置には、ビームストップ36が配置されている。ビームストップ36は、ウエバ支持ホイール32を通過したイオンビーム(IB)を受け止めるためのものであり、またイオン圧入の制御のためにイオンビーム照射量を検出するためのイオン検出器が配置されている。イオン注入部14は、ターゲットチャンバ32の壁面にバルブ38、40を介して第2の減圧手段として真空ポンプ、例えばクライオポンプ42、44がそれぞれ接続されている。

ウエハ支持ホイール32は、ターケットチャンバ30内に揺動可能に取り付けられた揺動シャフト46と、その先端に回転可能に取り付けられたハブ48と、このハブ48から放射状に延びる複数本のアーム50とから構成されている。各アーム50の先端には、ウエハWを保持するためのウエハホルグ52が設けられている。ハブ48は、図1に示された矢印Aの方向に回転駆動させられ、また、揺動シャフト46は、図1に示された矢印Bの方向に沿って所定の角度で揺動させられる。

ウエハローダ部16は、クーゲットチャンバ30に隣接して配置されている。 ウエハローダ部16では、ハウシング54とクーゲットチャンバ30との間が、 搬送路56によって連通されている。この搬送路56にはアイソレーションバル ブ58が設けられており、ハウジング54とクーゲットチャンバ30との間を分 離できるようにしている。このため、ウエハローダ16のみを雰囲気に開放する ことができるので、オペレータは、複数枚のウエハWが収容されたカセット(図 示せず) をハウジング54内に設置することができる。カセット内のウエハWは、ロホット (団示せず) によって搬送され、ターゲットチャンバ30内のウエハ支持ホイール32の各ウエハホルグ52に取り付けることができる。

図3~图5を参照しながら、ピームガイド部24について説明する。図3は、受入口24aから送出口24bを見たときのビームガイト部24の内部の斜視図である。図4は、図3のI-I' 断面における断面図である。図4は、イオンビームが進行する方向に向いた軸を含む平面においてビームガイド部24を模式的に示した断面図である。図5は、図4のII-II' 断面における断面図である。

5

10

15

20

25

ピームガイト部24では、受入日24aはイオン源部の後段加速系(图2の符号23)に接続され、送出口24bはイオン注入部(図2の符号14)内部につながる開口34を有する。受入口24aと送出口24bとは、受入口24aから送出口24bに伸びるガイド管24cによってつながれている。このため、ガイド管24c内は、イオンビーム64が通過する通路であり、通過したイオンはウエハ92に到達する。ウエハ92は、ウエハホルダ52に取り付けられている。また、別のウエハホルダ52には、同様に、ウエハ94が取り付けられている。また、別のウエハホルダ52には、同様に、ウエハ94が取り付けられている。これらの複数のウエハは、イオンビーム64の進む軸の方向と垂直な平面内において高速に回転している。このため、これら複数のウエハ92、94はイオンビームに対して順次に移動するので(図4の矢印で方向)、これらのウエハ92、94に対して繰り返してイオン注入が行われる。

ビームガイト部24の外側面には、荷電粒子発生器62が設けられている。この荷電粒子発生器62は、ターケットチャンパ30内に配置されている。荷電粒子発生器62は、2つの端子を有するフィラメントコイル68と、フィラメントコイル68を内部に収納したプラズマ発生チャンパ66と、プラズマ発生チャンパ66内に生成されるプラズマを増強するためのプラスマ強化磁石70と、を含む。フィラメントコイル68の2つの端子68a、68bは、プラズマ発生チャンパん6の一面から電気的に絶縁された状態でチャンパ外へ引き出されて、電源

72に接続されている。電源72として、例えば、直流電圧が5ボルトで、電流 供給容量が200アンペアのものを使用する。

プラスマ発生チャンバ66内にプラスマを発生させるために、封入カス、例えばアルゴンガスが、ガス供給管74からプラズマ発生チャンバ66に供給される。フィラメントコイル68に流れる電流が、フィラメント24自体を加熱するので、フィラメントコイル68はプラスマ発生チャンバ66内に熱的に電子を放出する。フィラメントコイル68とチャンバ66の外周部76と間には、チャンバ66側がフィラメントコイル68に対して高電位になるように、電源78が接続されている。電源78としては、例えば、直流電圧が50ボルトで、電流供給容量か6アンペアのものを使用する。このため、フィラメントコイル68から熱電子が放出されるようになると、チャンバ66内にはプラズマが発生して、フィラメントからの電子放出を増大させる。このように、荷電粒子発生器62は、電子発生器であり、このため、チャーシニュートライザの機能を有する。

5

10

15

20

25

プラズマ発生チャンハ66と、ビームガイド部24とは、導入管(導入部)8 0によって接続されている。導入管80は、ガイド管24cの内壁24dにその 間口82を有し、荷電粒子発生器62からの荷電粒子はこの開口82を通過して カイド管24c内に導かれる。このため、発生された熱電子の一部は、拡散によ って導入管80を通過してビームガイド部24内に放出される。このような開口 82の典型的な形状は、円または楕円であり、またその典型的な大きさは、中心 を通る径にして、3mm~5mmである。

一方、電流によって加熱されたフィラメント68からは、熱電子だけでなく電極を構成する金属材料の粒子も放出される。イオン汪入装置の荷電粒子発生器62では、フィラメント68はケングステンから形成されている。このため、荷電粒子発生器62からは、電子と共にタングステン原子も放出される。このタングステン原子はシリコンウエハに導入されると、半導体デバイスに対して好ましくない影響を及ぼす。したかって、タングステン原子がウエハに到達しないような

方策が必要となる。

5

10

15

20

25

このために、本実施形態のイオン注入装置10は、シールド部84を備える。 シールド部84は、ガイド管24cの内壁面24dにおいて、導入管80の開口 82と送出口24bとの間に位置する。

このようなシールド部84がウエハの汚染を防止するために好適である理由を以下に説明する。イオン源部18(図2 参照)において生成されたイオンがイオン注入部14(図2 参照)に導入される際に通過するビームガイド部24には、イオンと反対の電荷を有する荷電粒子が発生される荷電粒子発生器62が設けられている。このため、荷電粒子発生器62からはウエハに対して汚染物質となる汚染粒子(フィラメントの構成元素であるタングステン原子)も発生される。しかしながら、導入管80の開口82と送出口24 b との間に位置するシールド部84をガイド管24 a の内壁24 d に設ければ、カイド管内壁24 d の開口82から飛び出してウエハ92に直接に到達する粒子の経路が遮断される。このため、タングステン原子によるウエハの汚染が防止される。

図4に示された例示では、開口82から飛び出してウエハ92に直接に到達する経路のみか対象とされている。これに関して、発明者は、以下の理由によると考えている。一般に、このようなイオン注入装置のビームカイド部24内は、高い真空度に保たれている。なぜなら、受入口24aから入射するイオンピーム64の非常に多くの部分が送出口24bまで到達するためには、イオンピーム64のイオンはほとんと残留ガスと衝突しないような真空度が達成されている必要がある。このような真空度にビームカイド部24か保たれていると、その中の粒子が互いに衝突する確率よりも、粒子かイオン注入装置つまりビームカイト部24の壁面24d等と衝突する確率が大きい。したかって、間口82から飛び出したタンクステン原子は、様々な方向の速度を有しているけれども、特にウエハ92の方向、図4の例示では破線88内に速度ヘクトルが向いたクングステン原子は、他の粒子と衝突しなければ、直接にウエハ92の表面に達する。この他の速度べ

クトルを有する粒子は壁面24dと衝突することによって、その運動方向がウエハ92の方向に変更されなくてはならない。この確率は小さい。故に、開口82から飛び出してウエハ92に直接に到達するクンクステン原子の経路が、遮断されれば十分である。

図4および図5を参照すると、2点鎖線86によって挟まれる領域は、ウエハ92が移動してその全表面がビームガイド部24の送出部24bに現れた場合を示している。破線88によって囲まれる領域は、ウエハ92が更に移動してその全表面がビームガイド部24の送出部24bのほぼ中央に現れた場合を示している。一点鎖線90によって囲まれる領域は、ウエハ92が移動してその表面の一部かビームガイド部24の送出部24bから消え始める時を示している。

5

10

15

20

25

開口82の周囲上の2点、82a、82bを例示しながら、ウエハの汚染を防止するために必要な事柄に関して更に説明する。点82aは、開口82上の点のうち、送出口24bに最も近い点であり、点82bは、開口82上の点のうち、送出口24bに最も遠い点である。シールト部84の遮蔽面84aは、点82aからウエハ92の表面の各点に至る直線の群の少なくとも一部と交差している。同様にして、シールド部84の遮蔽面84aは、点82bからウエハ92の表面の各点に至る直線の群の少なくとも一部と交差している。交差している直線が示す経路を飛んで行くタングステン原子は、ウエハ表面に到達する前にシールド部84、つまり遮蔽面84aに衝突する。このため、この原子はウエハ表面に到達しない。

点82aおよび点82bを代表的に説明したか、開口82によって規定される 開口面の各点において、同様な直線の群が規定される。このような各点において 規定された直線のすべてからなる直線群の少なくとも一部が、シールド部84の 遮蔽面84aと交差するように、遮蔽面84aを設ければクングステン原子によ って引き起こされる汚染を防止する上で好適である。

特に、図4が示す断面(平面)内において、シールド部84の遮蔽面84aは、

点82aからウエハ92の表面の各点に至る全直線と交差している。同様にして、 シールド部84の遮蔽間84aは、点82bからウエハ92の表面の各点に至る 全直線と交差している。また、遮蔽面84aは、開口82によって規定される面 上の点の名々からウエハ92の表面の点の各々に至る直線の全てと交差している。

図5には、開口82の面上の全ての点からウエハ92の表面の各点に至る全直線が遮蔽面84aと交響する場合を示しており、これらの直線の群によって規定される外形84bが、シールト部84の遮蔽面84a上に示されている。この場合には、ほぼ完全に汚染を防止できる。

以下、遮蔽面84aについて、より詳細に説明する。

5

15

20

25

10 遮蔽面 8 4 a は、導入管 8 0 の開口 8 2 によって規定される面の各点からイオン注入部 1 4 に配置されるウエハ 9 2 のイオン注入されるべき表面の各点に至る直線と交わるようにすることが好ましい。このような遮蔽面 8 4 a を設けると、カイド管内壁 2 4 d の開口 8 2 から飛び出してウエハ 9 2 に直接に到達する汚染粒子の経路が遮断される。

また、遮蔽面84aは、開口82の縁部82aの近傍から開口82の上方に伸び出すようにすることが好ましい。このような遮蔽面82aを設けると、ガイド管内壁24dの開口から飛び出してイオン注入部14にウエハに直接に到達する汚染粒子の経路が、簡単な構造のシールド部84によって遮断される。

更に、遮蔽面84aは、導入管80の開口82によって規定される面の各点からイオンピーム部24の送出口24bによって規定される面の各点に至る直線と交わることが好ましい。このような遮蔽面84aを設けると、ウエハ92が送出口を移動しているいかなるときでも、ガイト管内壁24dの開口82から飛び出してウエハ92に直接に到達する汚染粒子の経路が遮断される。

このようなシールト部84は、遮蔽面84aを一端に有し、遮蔽面84aかガイト管の壁面24dと鋭角を成し、内壁24d上をイオンビーム64の方向に延 つる平板状の部材であることができる。また、シールト部84は、一の面が遮蔽

面84aを成し壁面24dから鋭角を成して延び出した平板と、この平板を支持 するフレーム部材によって構成してもよい。

図3を参照すると、簡単のためにビームガイ!部24、電荷発生部62、シールド部84のみを示している。ビームガイド部24の内壁24dには、導入管80の開口82が位置している。シールド部84の遮蔽面84a上には開口80上に各点とウエハ92上の各点を結ぶ直線の群の外形84bが示されている。このように、開口82の縁部から開口82をその上方において覆うように延び出した遮蔽平面84aを設けたので、かかる直線の群の少なくとも一部と交差するようにできる。また、このような直線の群の全てと支差するように遮蔽平面84aを形成することが好ましい。

このようなシールド部84を形成するために好適な材料としては、グラファイトが好ましい。また、所定の材料にてシールド部84を形成した後に、グラファイトの表面被覆処理を施して汚染を防止することもできる。

このように、フィラメント68をシールドするためのシールド部84を備えた イオン注入装置に関する実験結果を示す。実験に使用したイオン注入条件を以下 に示す。

イオン種: As

5

10

加速エネルギ:80keV

ドース量: 5×10¹⁵/cm²

20 この条件において、シールド部84の有無によって基板内のタングステン量を 分析した。この分析は、誘導結合プラズマ質量分析法 (ICP-MS) を用いて行った。 その実験結果は、

フィラメント・シールド取付前: 2. $4 \times 10^{12} atoms/cm^2$

フィラメント・シールド取付後:1.6×10 10 atoms/cm 2

25 となった。フィラメントを有するチャンバにつながる開口をウエハから見込む角度の全部が遮断されるように、シールト部84を設けた。この結果として、汚染

元素の原子数が1/10以下に低渡された。

産業上の利用可能性

5

10

以上、詳細に説明したように、本発明に係るイオンに入装置では、荷電粒子発生器が、イオンビームをイオン注入部に送るために通過するビームガイド部に設けられている。このため、この荷電粒子発生器においては、イオンと反対の電荷を有する荷電粒子が発生されると共に、基板に対して汚染物質となる汚染粒子も発生される。しかしながら、導入部の開口と送出口との間に配置されたシールド部をガイド管の内面上に設けたので、ガイド管内壁の開口から飛び出して基板に到達する汚染粒子の経路が遮断可能となる。故に、荷電粒子発生器から生じる汚染粒子によって基板が汚染されることが防止できるイオン注入装置が提供される。

請求の範囲

1. イオンを生成するイオン源部と、

前記イオン源部において生成された前記イオンが基板にイオン注入されるイオン注入部と、

前記イオンと反対の電荷を有する荷電粒子を発生する荷電粒子発生器と、

前記イオン源部からの前記イオンを受け入れるための受入口、前記イオン注入 部へ前記イオンを送出するための送出口、前記受入口から前記送出口に伸びるガ イド管、および前記ガイド管の内面にその開口が設けられ前記荷電粒子発生器か らの前記荷電粒子を前記ガイド管内に導くための導入部、を有するビームガイド 部と、

前記ガイド管の内部において、前記導入部の前記開口と前記送出口との間に位置するシールド部と、

を備えるイオン注入装置。

5

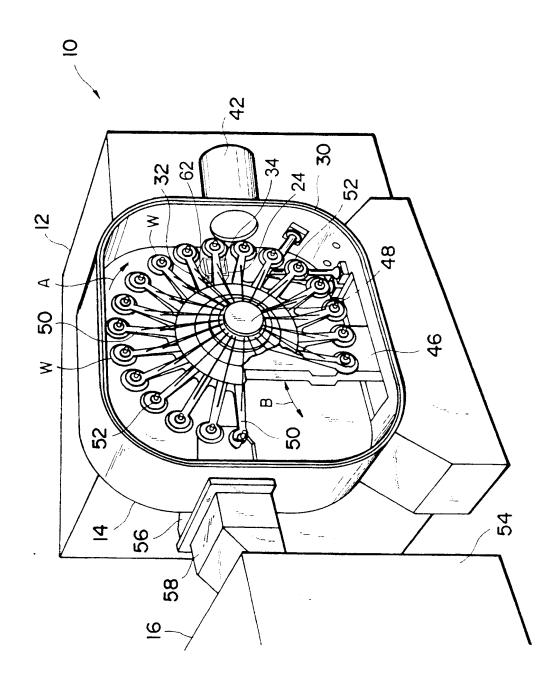
10

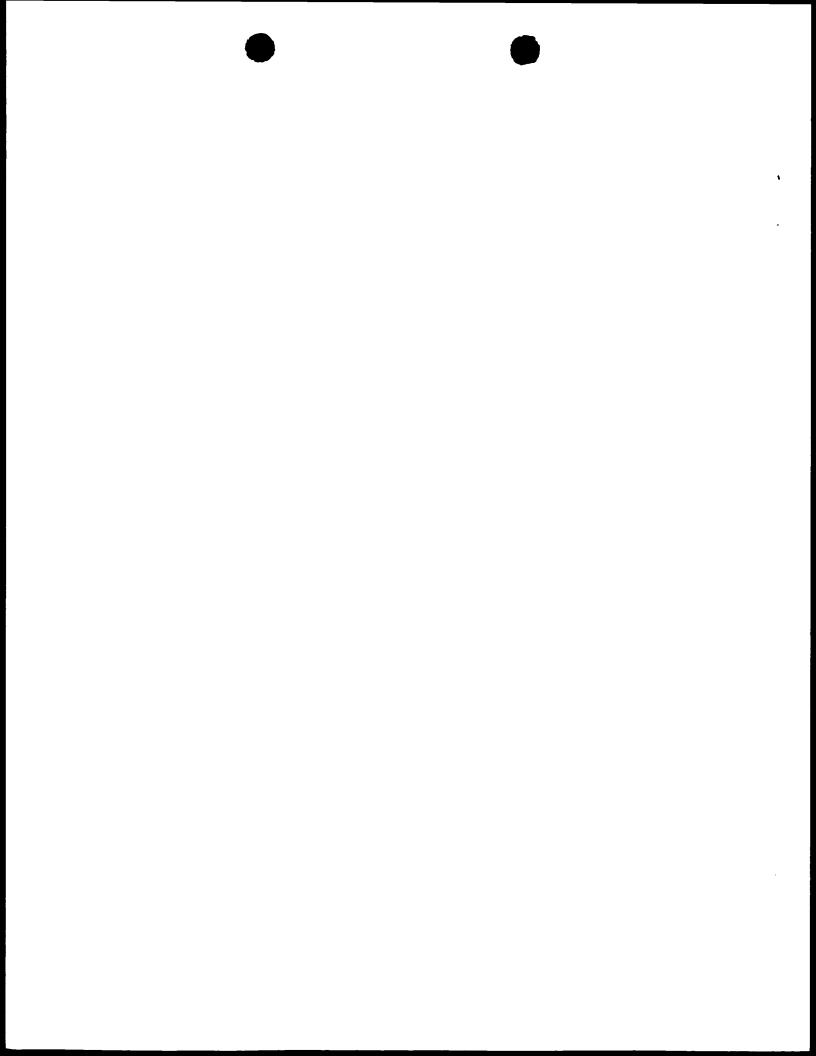
20

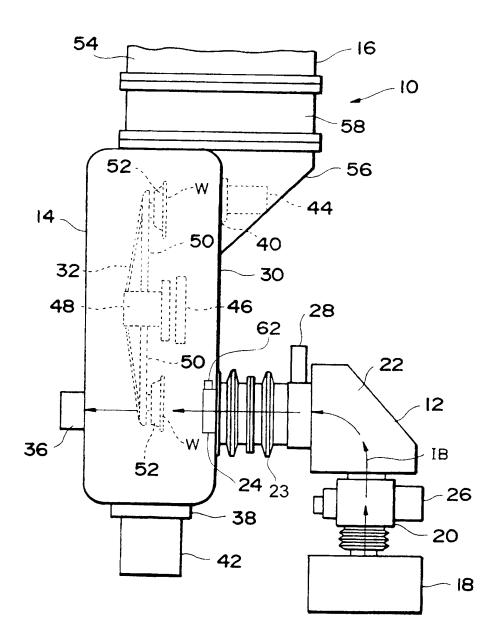
25

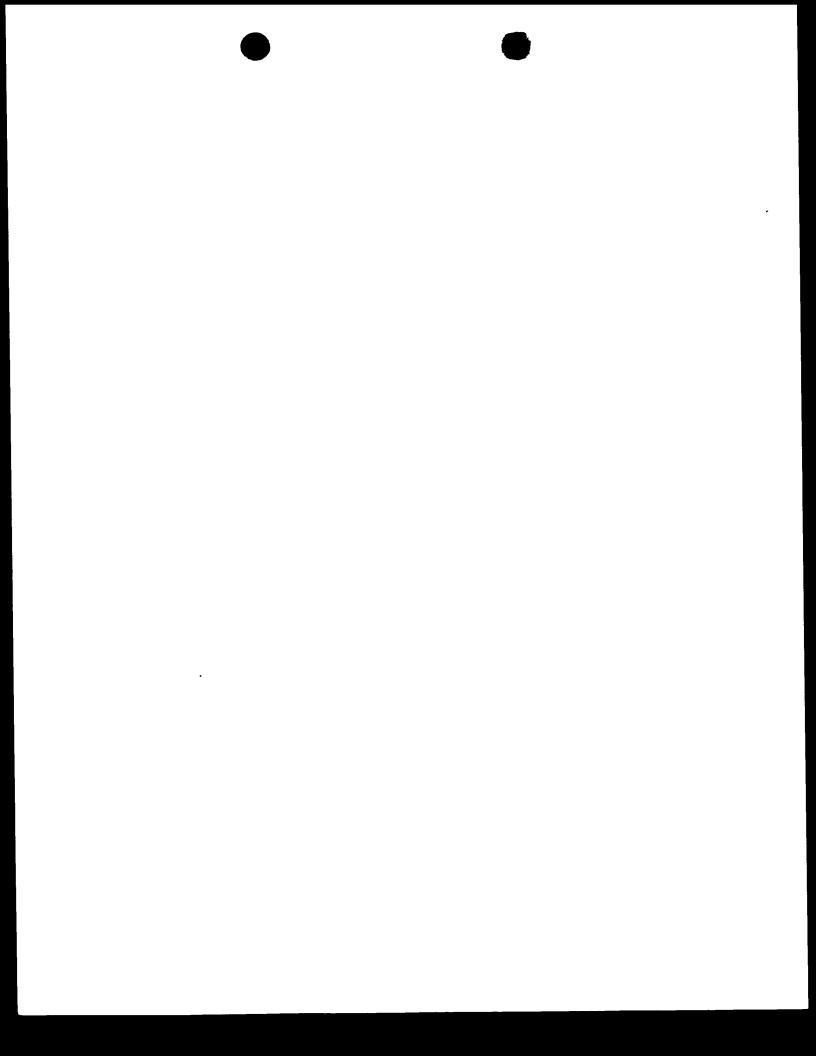
- 2. 前記シールド部は、前記導入部の前記開口によって規定される面の各点から前記イオン注入部に配置されるイオン注入されるべき前記基板の表面の各点に至る直線と交わる遮蔽面を有する、ことを特徴とする請求項1に記載のイオン注入装置。
 - 3. 前記シールド部は、前記開口の縁部近傍から前記開口の上方に伸び出す 遮蔽面を有する、ことを特徴とする請求項1に記載にイオン注入装置。
 - 4. 前記シールド部は、前記導入部の前記開口によって規定される面の各点から前記イオンビーム部の前記送出口によって規定される面の各点に至る直線と交わる遮蔽面を有する、ことを特徴とする請求項1に記載のイオン注入装置。
 - 5. 前記シールド部は、前記遮蔽面は前記ガイド管の内壁面と鋭角をなし、 且つ、平板形状をなしていることを特徴とする請求項2に記載のイオン注入装置。
 - 6. 前記シールド部は、前記遮蔽面を有すると共に前記ガイド管の内壁面と

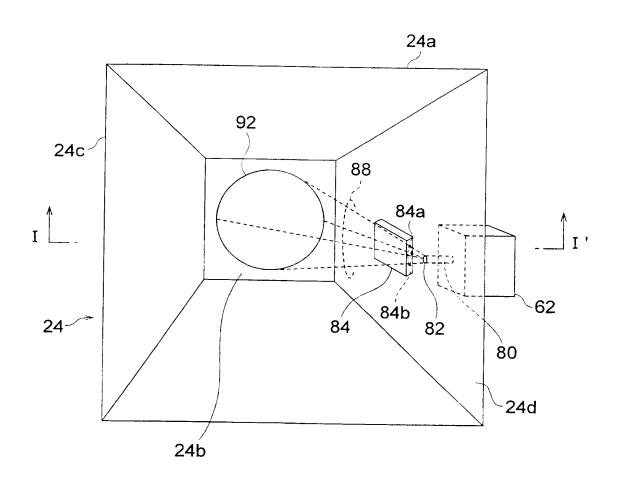
鋭角をなして配置された平板と、前記平板を支持するフレーム部材と、を含むことを特徴とする請求項2に記載のイオン注入装置。

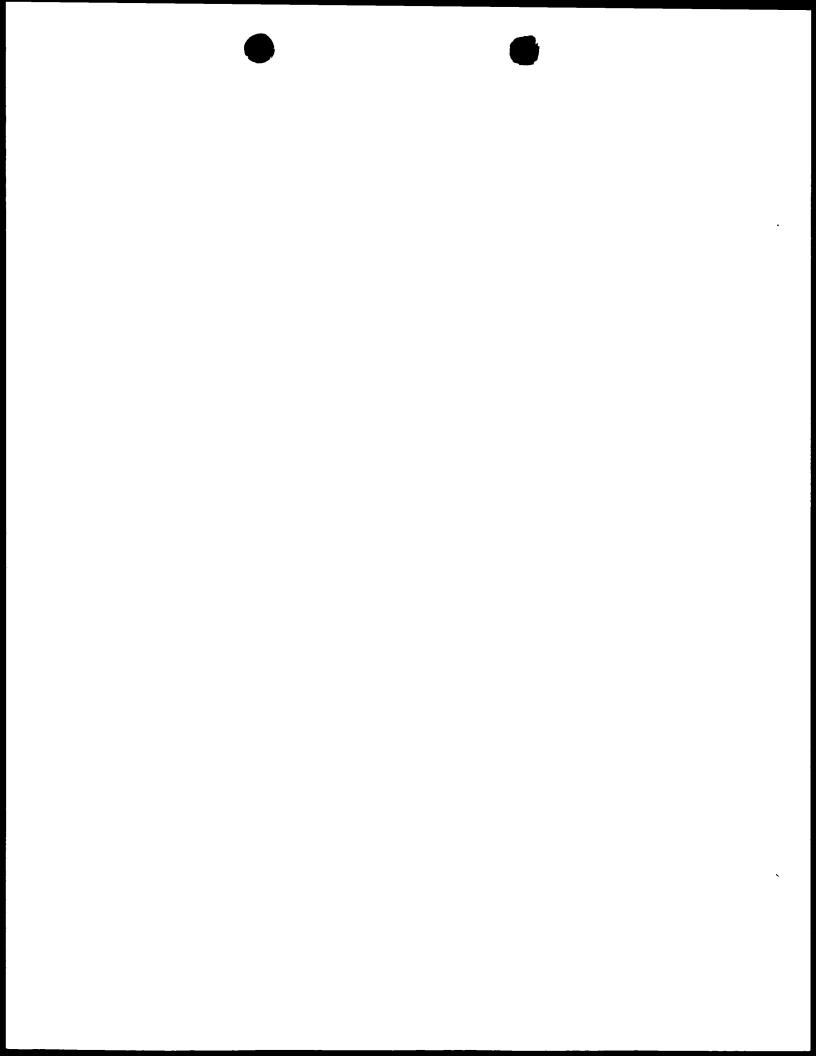


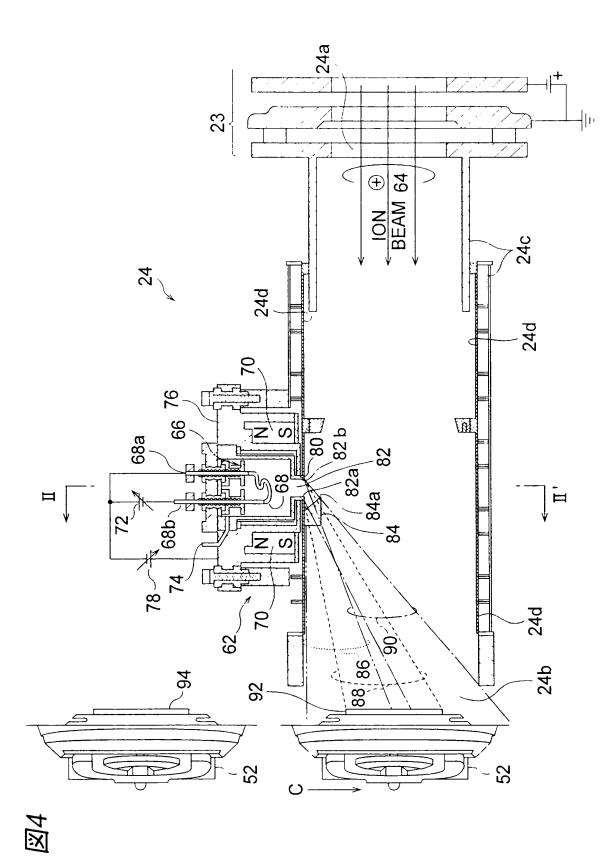




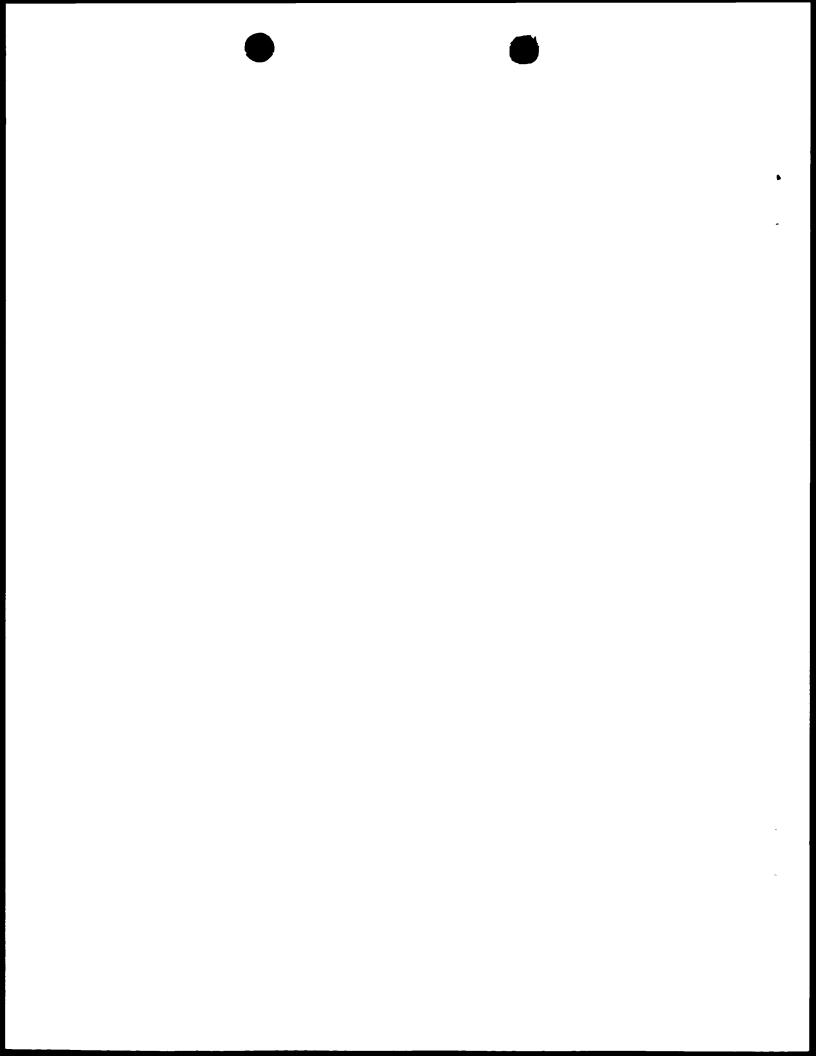


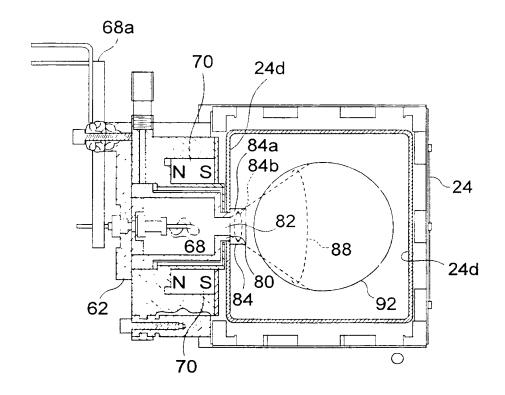






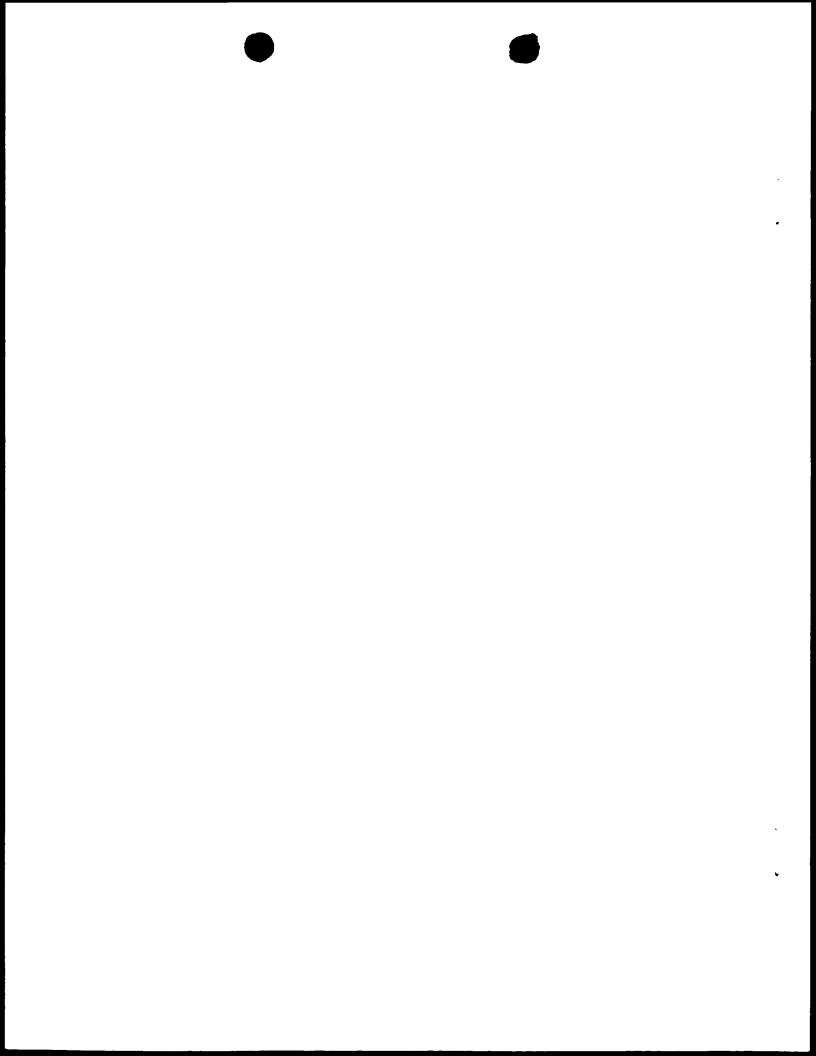
4/5





		•

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H01J37/302, 37/317					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
	SEARCHED				
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H01J37/302, 37/317					
Jits Koka	on searched other than minimum documentation to the cuyo Shinan Koho 1926-1996 i Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999 ata base consulted during the international search (name	Toroku Jitsuyo Shinan Ko Jitsuyo Shinan Toroku Ko	oho 1994-1999 oho 1996-1999		
	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	or data base and, where practicable, sear	en terms used)		
Category*	Citation of document, with indication, where any	proprieto, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
X	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages JP, 6-13019, A (TOKYO ELECTRON LIMITED), 21 January, 1994 (21.01.94), Full text; Figs. 1 to 4 (Family: none)		1-3		
Y	JP, 6-13019, A (TOKYO ELECTRON LIMITED), 21 January, 1994 (21.01.94), Full text; Figs. 1 to 4 (Family: none)		4-6		
Y	JP, 6-51100, A (Hitachi, Ltd.), 25 February, 1994 (25.02.94), Full text; Figs. 1 to 3 & US, 5466929, A & US, 5576538, A & US, 5668368, A		4 - 6		
Y	JP, 6-267439, A (Hitachi, Ltd.), 22 September, 1994 (22.09.94), Fig. 1; Par. Nos. [0013]-[0020] (Family: none)		1-6		
Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family			
Date of the actual completion of the international search 25 January, 2000 (25.01.00) Date of mailing of the international search report 01 February, 2000 (01.02.00)					
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer			
Facsimile No.		Telephone No.			



国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP99/06038

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))				
Int	C 1 7 H01J37/302, 37/317			
B. 調査を行	テった分野			
	b小限資料(国際特許分類(IPC))			
	G 1 7 HOLYOF (000 DF (015			
Int	C 1 ⁷ H01J37/302, 37/317			
	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの			
日本国关州	新案公報 1926-1996年 実用新案公報 1971-1999年			
日本国登録	日本国登録実用新案公報 1994-1999年			
日本国実用	新案登録公報 1996-1999年			
国際調査で使用	目した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)		
G BRY L	* 1 321 1 A 1 - 7 - 4++h			
C. 関連する 引用文献の	ろと認められる文献 		関連する	
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号	
X	JP、6-13019、A(東京エレクト	ロン株式会社)	1-3	
	21.1月.1994 (21.01.94) 全文、	第1-4図(ファミリーなし)		
Y	JP、6-13019、A(東京エレクト	ロン株式会社)	4-6	
_	21.1月.1994 (21.01.94) 全文、			
Y	JP、6-51100、A(株式会社日立	製作所)	4-6	
	25.2月.1994(25.02.94)全文、	第1-3図		
	& US, 5466929, A & U & US, 5668368, A	S 、5576538、 A		
	& US, 5000500, A			
			16rt + +> 977	
X C欄の続き	きにも文献が列挙されている。 	パテントファミリーに関する別	紙を参照。 	
* 引用文献(のカテコリー	の日の後に公表された文献		
1	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表		
もの て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 論の理解のために引用するもの			、光·列•//凉垤又は垤	
以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで				
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の				
	文献(理由を付す) よの文献と明明を指述するために引用する 「1」特に関連のある文献とあって、当成文献と他の19			
	「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの			
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献				
国際調査を完了した日				
	25.01.2000	01.0	200	
国際調査機関	の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	2G 8704	
	国特許庁(ISA/JP)	杉浦 淳 F	lì ——————	
	郵便番号100-8915 都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3224	



国際出願番号 PCT/JP99/06038

C (続き).	関連すると認められる文献	日日、おこよって
引用 文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP、6-267439、A(株式会社日立製作所) 22.9月.1994(22.09.94) 第1図、段落番号【0013-0020】 (ファミリーなし)	1-6